

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60747-5-1**

Première édition  
First edition  
1997-08

---

---

**Dispositifs discrets à semiconducteurs  
et circuits intégrés –**

**Partie 5-1:  
Dispositifs optoélectroniques –  
Généralités**

**Discrete semiconductor devices  
and integrated circuits –**

**Part 5-1:  
Optoelectronic devices –  
General**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60747-5-1:1997

## Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

## Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**  
Accès en ligne\*
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Accès en ligne)\*

## Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)*.

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

## Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

\* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

## Numbering

As from the 1st January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

## Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**  
On-line access\*
- **Catalogue of IEC publications**  
Published yearly with regular updates (On-line access)\*

## Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

## IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

\* See web site address on title page.

NORME  
INTERNATIONALE

CEI  
IEC

INTERNATIONAL  
STANDARD

60747-5-1

Première édition  
First edition  
1997-08

---

---

**Dispositifs discrets à semiconducteurs  
et circuits intégrés –**

**Partie 5-1:  
Dispositifs optoélectroniques –  
Généralités**

**Discrete semiconductor devices  
and integrated circuits –**

**Part 5-1:  
Optoelectronic devices –  
General**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

U

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS .....	4
Articles	
1 Domaine d'application.....	6
2 Références normatives .....	6
3 Concepts physiques.....	6
3.1 Rayonnement (électromagnétique); radiation (électromagnétique).....	6
3.2 Rayonnement optique .....	6
3.3 Rayonnement visible .....	6
3.4 Rayonnement infrarouge .....	6
3.5 Rayonnement ultraviolet .....	8
3.6 Lumière .....	8
3.7 Effet photoélectrique .....	8
4 Types de dispositifs .....	8
4.1 Dispositif optoélectronique à semiconducteurs.....	8
4.2 Photoémetteur à semiconducteurs.....	8
4.3 Laser à semiconducteurs.....	8
4.4 Diode électroluminescente.....	8
4.5 Diode émettrice en infrarouge.....	9
4.6 Dispositif photosensible (à semiconducteurs).....	10
4.7 Récepteur photoélectrique (à semiconducteurs).....	10
4.8 Photorésistance (à semiconducteurs), cellule photoconductrice .....	10
4.9 Photopile, cellule photovoltaïque.....	10
4.10 Photodiode.....	10
4.11 Phototransistor .....	10
4.12 Photothyristor.....	10
4.13 Photocoupleur, optocoupleur .....	10
5 Termes généraux .....	10
5.1 Axe optique .....	10
5.2 Accès optique (d'un dispositif optoélectronique à semiconducteurs).....	10
5.3 Gaine (optique) .....	18
6 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques .....	20
6.1 Généralités.....	20
6.2 Photoémetteurs .....	22
6.3 Dispositifs photosensibles .....	40
6.4 Photocoupleurs, optocoupleurs.....	46
Annexe A – Index de références croisées .....	56

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	5
Clause	
1 Scope.....	7
2 Normative references .....	7
3 Physical concepts.....	7
3.1 (Electromagnetic) radiation.....	7
3.2 Optical radiation .....	7
3.3 Visible radiation.....	7
3.4 Infrared radiation.....	7
3.5 Ultraviolet radiation.....	7
3.5 Light.....	9
3.6 Photoelectric effect.....	9
4 Types of devices.....	9
4.1 Semiconductor optoelectronic device.....	9
4.2 Semiconductor photoemitter.....	9
4.3 Semiconductor laser.....	9
4.4 Light-emitting diode (LED).....	9
4.5 Infrared-emitting diode (IRED).....	9
4.6 (Semiconductor) photosensitive device .....	11
4.7 (Semiconductor) photoelectric detector.....	11
4.8 (Semiconductor) photoresistor, photoconductive cell.....	11
4.9 Photoelement, photovoltaic cell.....	11
4.10 Photodiode.....	11
4.11 Phototransistor.....	11
4.12 Photothyristor.....	11
4.13 Photocoupler, optocoupler.....	11
5 General terms.....	11
5.1 Optical axis .....	11
5.2 Optical port (of a semiconductor optoelectronic device).....	11
5.3 (Optical) cladding .....	19
6 Terms related to ratings and characteristics.....	21
6.1 General.....	21
6.2 Photoemitters.....	23
6.3 Photosensitive devices .....	41
6.4 Photocouplers, optocouplers.....	47
Annex A – Cross references index.....	57

# COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## DISPOSITIFS DISCRETS À SEMICONDUCTEURS ET CIRCUITS INTÉGRÉS –

### Partie 5-1: Dispositifs optoélectroniques – Généralités

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60747-5-1 a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs optoélectroniques, d'affichage et d'imagerie, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Cette première édition remplace partiellement la deuxième édition de la CEI 60747-5 (1992) et constitue une révision technique. (Voir également annexe A: Index des références croisées).

Elle doit être lue conjointement avec la CEI 60747-1, la CEI 62007-1 et la CEI 62007-2.

Le texte de cette norme est issu en partie de la CEI 60747-5 (1992) et en partie des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47C/173/FDIS	47C/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES  
AND INTEGRATED CIRCUITS –****Part 5-1: Optoelectronic devices –  
General**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60747-5-1 has been prepared by subcommittee 47C: Optoelectronic, display and imaging devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This first edition replaces partially the second edition of IEC 60747-5 (1992) and constitutes a technical revision (see also annex A: Cross references index).

It should be read jointly with IEC 60747-1 and IEC 62007-1 and IEC 62007-2.

The text of this standard is based partially on IEC 60747-5 (1992) and partially on the following documents:

FDIS	Report on voting
47C/173/FDIS	47C/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.

# DISPOSITIFS DISCRETS À SEMICONDUCTEURS ET CIRCUITS INTÉGRÉS –

## Partie 5-1: Dispositifs optoélectroniques – Généralités

### 1 Domaine d'application

Cette partie de la CEI 60747 a pour sujet la terminologie propre aux dispositifs opto-électroniques à semiconducteurs.

### 2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60747. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60747 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60050(731):1991, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 731: Télécommunications par fibres optiques*

CEI 60050(845):1987, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 845: Eclairage*

CEI 60664-1:1992, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, prescriptions et essais*

### 3 Concepts physiques

#### 3.1 Rayonnement (électromagnétique); radiation (électromagnétique) (VEI 845-01-01)

- 1) Emission ou transport d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques avec les photons associés.
- 2) Ces ondes électromagnétiques ou ces photons.

#### 3.2 Rayonnement optique (VEI 845-01-02)

Rayonnement électromagnétique dont les longueurs d'onde sont comprises entre le domaine de transition vers les rayons X ( $\approx 1$  nm) et le domaine de transition vers les ondes radioélectriques ( $\approx 1$  nm).

#### 3.3 Rayonnement visible (VEI 845-01-03)

Rayonnement optique susceptible de produire directement une sensation visuelle.

NOTE – Il n'y a pas de limites précises pour le domaine spectral du rayonnement visible; ces limites dépendent du flux énergétique disponible et de la sensibilité de l'observateur. La limite inférieure est prise généralement entre 360 nm et 400 nm et la limite supérieure entre 760 nm et 830 nm.



# DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS –

## Part 5-1: Optoelectronic devices – General

### 1 Scope

This part of IEC 60747 deals with the terminology relating to the semiconductor optoelectronic devices.

### 2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60747. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 747 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(731),1991, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 731: Optical fibre communication*

IEC 60050(845):1987, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 845: Lighting*

IEC 60664-1:1992, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

### 3 Physical concepts

#### 3.1 (Electromagnetic) radiation (IEV 845-01-01)

- 1) Emission or transfer of energy in the form of electromagnetic waves with the associated photons.
- 2) These electromagnetic waves or these photons.

#### 3.2 Optical radiation (IEV 845-01-02)

Electromagnetic radiation of wavelengths lying between the region of transition to X-rays ( $\approx 1$  nm) and the region of transition to radio waves ( $\approx 1$  nm).

#### 3.3 Visible radiation (IEV 845-01-03)

Any optical radiation capable of causing a visual sensation directly.

NOTE – There are no precise limits for the spectral range of visible radiation since they depend upon the amount of radiant power available and the responsivity of the observer. The lower limit is generally taken between 360 nm and 400 nm and the upper limit between 760 nm and 830 nm.

### **3.4 Rayonnement infrarouge** (VEI 845-01-04, spécialisé)

Rayonnement optique dont les longueurs d'onde sont supérieures à celles du rayonnement visible.

### **3.5 Rayonnement ultraviolet** (VEI 845-01-05, spécialisé)

Rayonnement optique dont les longueurs d'onde sont inférieures à celles du rayonnement visible.

### **3.6 Lumière** (VEI 845-01-06, sans la note 2 qui n'est pas appropriée)

#### **3.6.1 Lumière perçue** (voir VEI 845-02-17)

#### **3.6.2 Rayonnement visible** (voir VEI 845-01-03)

NOTE – Le concept 2 est parfois employé pour des rayonnements optiques s'étendant en dehors du domaine visible, mais cet usage n'est pas recommandé.

### **3.7 Effet photoélectrique** (extrait de VEI 845-05-33: récepteur photoélectrique)

Interaction entre le rayonnement optique et la matière résultant de l'absorption de photons et de la libération consécutive de porteurs de charges mobiles, produisant ainsi une tension ou un courant électrique, ou un changement de résistance électrique, en excluant tout phénomène électrique produit par des changements de température.

## **4 Types de dispositifs**

### **4.1 Dispositif optoélectronique à semiconducteurs**

- 1) Dispositif à semiconducteurs qui émet ou détecte ou est sensible à un rayonnement optique cohérent ou non cohérent.
- 2) Dispositif à semiconducteurs qui utilise un tel rayonnement pour son fonctionnement interne.

### **4.2 Photoémetteur à semiconducteurs**

Dispositif optoélectronique à semiconducteurs qui convertit directement l'énergie électrique en énergie optique rayonnante.

### **4.3 Laser à semiconducteurs**

#### **4.3.1 Diode laser (à semiconducteurs)**

Diode à semiconducteurs qui émet un rayonnement optique cohérent par une émission stimulée résultant de la recombinaison d'électrons libres et de trous lorsqu'elle est excitée par un courant électrique de valeur supérieure au courant de seuil de la diode.

NOTE – La diode laser est montée sur une embase ou dans un boîtier avec ou sans moyen de couplage (par exemple, lentille, fibre amorce).

#### **4.3.2 Module à diode laser**

Module qui comprend avec la diode laser un moyen pour la stabilisation optique et/ou thermique automatique du flux énergétique.

### **4.4 Diode électroluminescente**

Diode à semiconducteurs, autre qu'un laser à semiconducteurs, capable d'émettre un rayonnement visible lorsqu'elle est excitée par un courant électrique.

### 3.4 Infrared radiation (IEV 845-01-04, specialized)

Optical radiation for which the wavelengths are longer than those for visible radiation.

### 3.5 Ultraviolet radiation (IEV 845-01-05, specialized)

Optical radiation for which the wavelengths are shorter than those for visible radiation.

### 3.6 Light (IEV 845-01-06, without note 2 which is not relevant)

#### 3.6.1 Perceived light (see IEV 845-02-17)

#### 3.6.2 Visible radiation (see IEV 845-01-03)

NOTE – Concept 2 is sometimes used for optical radiation extending outside the visible range, but this usage is not recommended.

### 3.7 Photoelectric effect (from IEV 845-05-33: photoelectric detector)

Interaction between optical radiation and matter resulting in the absorption of photons and the consequent generation of mobile charge carriers, thereby generating an electric potential or current, or a change in electrical resistance, excluding electrical phenomena caused by temperature changes.

## 4 Types of devices

### 4.1 Semiconductor optoelectronic device

- 1) A semiconductor device that emits or detects or that is responsive to coherent or non-coherent optical radiation.
- 2) A semiconductor device that utilizes such radiation for its internal purposes.

### 4.2 Semiconductor photoemitter

A semiconductor optoelectronic device that directly converts electric energy into optical radiant energy.

### 4.3 Semiconductor laser

#### 4.3.1 (Semiconductor) laser diode

A semiconductor diode that emits coherent optical radiation through stimulated emission resulting from the recombination of free electrons and holes when excited by an electric current that exceeds the threshold current of the diode.

NOTE – The laser diode is mounted on a submount or in a package with or without coupling means (e.g. lens, pigtail).

#### 4.3.2 Laser-diode module

A module containing, together with the laser diode, means for an automatic optical and/or thermal stabilization of the radiant output power.

### 4.4 Light-emitting diode (LED)

A semiconductor diode, other than a semiconductor laser, capable of emitting visible radiation when excited by an electric current.

#### **4.5 Diode émettrice en infrarouge**

Diode à semiconducteurs, autre qu'un laser à semiconducteurs, capable d'émettre un rayonnement en infrarouge lorsqu'elle est excitée par un courant électrique.

#### **4.6 Dispositif photosensible (à semiconducteurs)**

Dispositif à semiconducteurs qui utilise l'effet photoélectrique pour détecter un rayonnement optique.

#### **4.7 Récepteur photoélectrique (à semiconducteurs)**

Dispositif à semiconducteurs qui utilise l'effet photoélectrique pour recevoir un rayonnement optique.

#### **4.8 Photorésistance (à semiconducteurs), cellule photoconductrice** (VEI 845-05-37, spécialisé)

Récepteur photoélectrique à semiconducteurs qui utilise la variation de la conductivité électrique produite par l'absorption d'un rayonnement optique.

#### **4.9 Photopile, cellule photovoltaïque** (VEI 845-05-38)

Récepteur photoélectrique qui utilise la force électromotrice produite par l'absorption d'un rayonnement optique.

#### **4.10 Photodiode** (VEI 845-05-39)

Récepteur photoélectrique dans lequel un courant photoélectrique est produit par l'absorption d'un rayonnement optique au voisinage d'une jonction PN entre les semiconducteurs, ou d'une jonction entre un semiconducteur et un métal.

#### **4.11 Phototransistor**

Transistor dans lequel le courant produit par l'effet photoélectrique au voisinage de la jonction émetteur-base joue le rôle de courant de base qui est amplifié.

#### **4.12 Photothyristor**

Thyristor qui est conçu pour être déclenché par un rayonnement optique.

#### **4.13 Photocoupleur, optocoupleur**

Dispositif optoélectronique à semiconducteurs conçu pour le transfert de signaux électriques par l'utilisation d'un rayonnement optique, afin d'assurer un couplage ainsi que l'isolement électrique entre l'entrée et la sortie.

### **5 Termes généraux**

#### **5.1 Axe optique**

Ligne autour de laquelle le diagramme principal de rayonnement ou de sensibilité est centré.

NOTE – Sauf spécification contraire, l'axe optique coïncide avec la direction du rayonnement maximal ou de la sensibilité maximale.

#### **4.5 Infrared-emitting diode (IRED)**

A semiconductor diode other than a semiconductor laser capable of emitting infrared radiation when excited by an electric current.

#### **4.6 (Semiconductor) photosensitive device**

A semiconductor device that utilizes the photoelectric effect for detection of optical radiation.

#### **4.7 (Semiconductor) photoelectric detector**

A semiconductor device that utilizes the photoelectric effect for detection of optical radiation.

#### **4.8 (Semiconductor) photoresistor, photoconductive cell (IEV 845-05-37, specialized)**

A semiconductor photoelectric detector that utilizes the change of electric conductivity produced by the absorption of optical radiation.

#### **4.9 Photoelement, photovoltaic cell (IEV 845-05-38)**

A photoelectric detector that utilizes the electromotive force produced by the absorption of optical radiation.

#### **4.10 Photodiode (IEV 845-05-39)**

A photoelectric detector in which a photocurrent is generated by absorption of optical radiation in the neighbourhood of a PN junction between the semiconductors, or of a junction between a semiconductor and a metal.

#### **4.11 Phototransistor**

A transistor in which the current produced by the photoelectric effect in the neighbourhood of the emitter-base junction acts as base current, which is amplified.

#### **4.12 Photothyristor**

A thyristor that is designed to be triggered by optical radiation.

#### **4.13 Photocoupler, optocoupler**

A semiconductor optoelectronic device designed for the transfer of electrical signals by utilizing optical radiation to provide coupling with electrical isolation between the input and the output.

### **5 General terms**

#### **5.1 Optical axis**

A line about which the principal radiation or sensitivity pattern is centered.

NOTE – Unless otherwise stated, the optical axis coincides with the direction of maximum radiation or sensitivity.

**5.2 Accès optique (d'un dispositif optoélectronique à semiconducteurs)**

Configuration géométrique référencée à un plan extérieur ou une surface extérieure du dispositif et destinée à spécifier le rayonnement optique émis par un dispositif émetteur ou reçu par un dispositif récepteur.

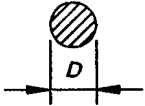
NOTE – La configuration géométrique doit être spécifiée par le fabricant à l'aide de paramètres géométriques, par exemple:

- position, forme et taille de la zone émettrice ou réceptrice,
- angle d'émission ou de réception,
- autres paramètres, tels que: ouverture numérique de la fibre optique,
- orientation de l'axe optique.

Exemples:

Signification des annotations dans les figures:

$\alpha$  = angle d'émission

 = accès optique de diamètre  $D$

Réf. = lieu de référence pour la définition de l'accès optique.

Exemple I: *Dispositifs avec fibre amorcée (émetteur ou récepteur)*

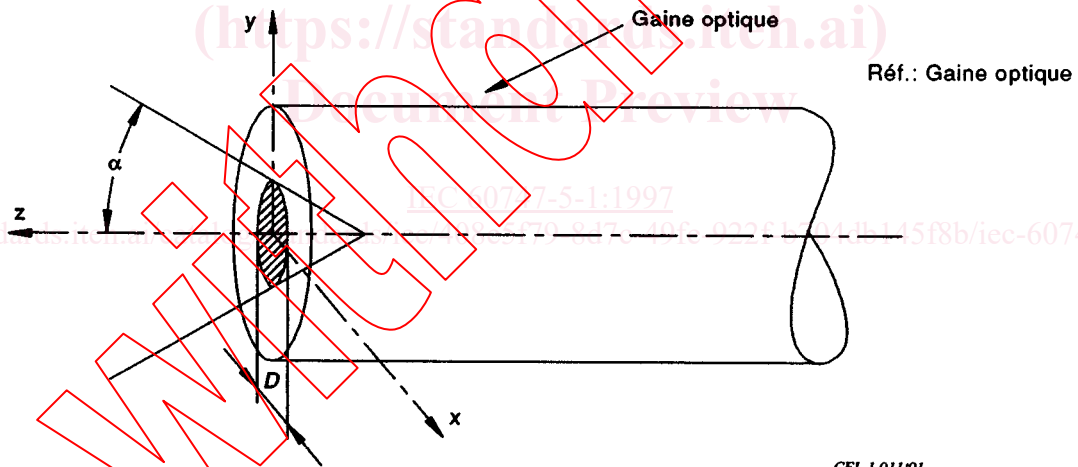


Figure 1a – Dispositif avec fibre amorcée nue

CEI 101191